JP2001156719

Publication Title:

OPTICAL TRANSMITTER

Abstract:

Abstract of JP2001156719

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve a problem in a conventional optical transmitter that a deteriorated extinction rate is unable to be compensated only an APC circuit because the temperature of a light emitting element rises together with increase in ambient temperature in the case that the transmitter is in operation under a condition in excess of a cooling limit temperature &Delta T=40 deg.C of a general cooling element such as a high temperature operation at 85 deg.C especially at a wide operating temperature range of -40 to 85 deg.C. SOLUTION: The optical transmitter is additionally provided with a temperature compensation function that detects the temperature of the light emitting element and increases the modulation current when the temperature exceeds a prescribed temperature.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Courtesy of http://v3.espacenet.com

This Patent PDF Generated by Patent Fetcher(TM), a service of Stroke of Color, Inc.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-156719 (P2001-156719A)

(43)公開日 平成13年6月8日(2001.6.8)

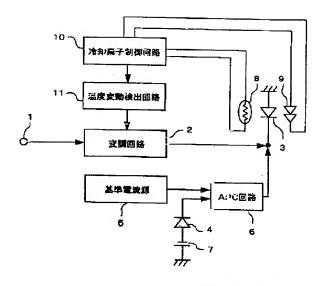
(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I - デーマコート*(参考)
	14	H 0 4 B 9/00 S 5 K 0 0 2
	/06	Y
	/04	
10/3 10/3		
	/26	審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 21 頁)
(21)出顧番号	特顯平11-334155	(71)出願人 000006013 三菱電機株式会社
(22) 街顧日	平成11年11月25日(1999,11.25)	東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
		(72)発明者 須田 博
		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内
		(74)代理人 100102439
		弁理士 宮田 金雄 (外2名)
		Fターム(参考) 5K002 AA01 CA09 CA11

(54) 【発明の名称】 光送信器

(57)【要約】

【課題】 従来の光送信器では、-40~85℃の広範囲温度動作条件下では、特に85℃での高温度動作のように、一般的な冷却素子の冷却限界温度ΔT=40℃を超えた条件で動作させた場合、外気温の上昇に併せて発光素子の温度も上昇してしまうため、APC回路だけでは消光比が悪くなるという問題があった。

【解決手段】 発光素子の温度を検出し、ある一定の温度を超えたところで、変調電流が増加するように温度補償機能を追加した。



11:溫度変動技出回路

【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力された送信データ信号を変調制御 し、変調電流を発光素子へ出力する変調回路と、前記発 光素子の出力背面光を受光して光電変換する検出受光素 子と、発光素子が発光するために必要な電流を供給する 基準電流源と、前記検出受光素子にて変換された検出受 光素子電流と基準電流源の基準電流との差に対応した発 光素子へのバイアス電流を供給するAPC(Autom aticPower Control) 回路と、前記検 出受光素子のバイアス電源と、前記発光素子の温度を検 出する温度検出素子と、前記発光素子の温度を制御する ための温度制御素子と、この温度制御素子の温度を制御 する制御回路と、この制御回路でモニターした発光素子 の温度モニター値を基に、発光素子が設定された温度か ら高い温度に上昇していないか検出し、温度が上昇して いた場合には前記変調回路から出力される変調電流を調 整するように制御信号を出力する温度変動検出回路とを 備えたことを特徴とする光送信器。

【請求項2】 入力された送信データ信号を変調制御 し、変調電流を発光素子へ出力する変調回路と、前記発 光素子の出力背面光を受光して光電変換する検出受光素 子と、前記発光素子が発光するために必要な電流を供給 する基準電流源と、前記検出受光素子にて変換された検 出受光素子電流と基準電流源の基準電流との差に対応し た発光素子へのバイアス電流を供給するAPC(Aut omatic Power Control)回路と、 検出受光素子のバイアス電源と、前記発光素子の温度を 検出する温度検出素子と、前記発光素子の温度を制御す るための温度制御素子と、この温度制御素子の温度を制 御する制御回路と、前記発光素子の周囲温度を検出し、 この検出した温度を基に、発光素子が設定された温度か ら高い温度に上昇していないか検出し、温度が上昇して いた場合には前記変調回路から出力される変調電流を調 整するように制御信号を出力する温度検出回路とを備え たことを特徴とする光送信器。

【請求項3】 入力された送信データ信号を変調制御し、変調電流を発光素子へ出力する変調回路と、前記発光素子の出力背面光を受光して光電変換する検出受光素子と、前記発光素子が発光するために必要な電流を供給する基準電流源と、前記検出受光素子にて変換された検出受光素子電流と基準電流源の基準電流との差に対応した発光素子へのバイアス電流を供給するAPC(Automatic Power Control)回路と、検出受光素子のバイアス電源と、前記発光素子の温度を制御受光素子の温度検出素子と、前記発光素子の温度を制御する温度検出素子と、前記発光素子の温度を制御する制御回路と、前記変調回路の出力である変調電流値を前記APC回路の出力であるバイアス電流値をモニターし、変調電流とバイアス電流の比が設定されたある値に一定となるように、前記変調回路とAPC回路に制

御信号を出力する演算回路とを備えたことを特徴とする 光送信器。

【請求項4】 入力された送信データ信号を変調制御 し、変調電流を発光素子へ出力する変調回路と、前記発 光素子の出力背面光を受光して光電変換する検出受光素 子と、前記発光素子が発光するために必要な電流を供給 する基準電流源と、前記検出受光素子にて変換された検 出受光素子電流と基準電流源の基準電流との差に対応し た発光素子へのバイアス電流を供給するAPC(Aut omatic Power Control)回路と、 検出受光素子のバイアス電源と、前記発光素子の温度を 検出する温度検出素子と、発光素子の温度を制御するた めの温度制御素子と、この温度制御素子の温度を制御す る制御回路と、この制御回路でモニターした発光素子の 温度モニター値を基に、前記発光素子が設定された温度 から高い温度に上昇していないか検出し、温度が上昇し ていた場合には変調回路から出力される変調電流を調整 するように制御信号を出力する温度変動検出回路と、前 記変調回路の出力である変調電流値と、APC回路の出 力であるバイアス電流値をモニターし、変調電流とバイ アス電流の比が設定されたある値に一定となるように、 前記変調回路とAPC回路に制御信号を出力する演算回 路とを備えたことを特徴とする光送信器。

【請求項5】 入力された送信データ信号を変調制御 し、変調電流を発光素子へ出力する変調回路と、前記発 光素子の出力背面光を受光して光電変換する検出受光素 子と、前記発光素子が発光するために必要な電流を供給 する基準電流源と、前記検出受光素子にて変換された検 出受光素子電流と基準電流源の基準電流との差に対応し た発光素子へのバイアス電流を供給するAPC(Aut omatic Power Control)回路と、 検出受光素子のバイアス電源と、前記発光素子の温度を 検出する温度検出素子と、前記発光素子の温度を制御す るための温度制御素子と、この温度制御素子の温度を制 御する制御回路と、前記発光素子の周囲温度を検出し、 この検出した温度を基に、発光素子が設定された温度か ら高い温度に上昇していないか検出し、温度が上昇して いた場合には前記変調回路から出力される変調電流を調 整するように制御信号を出力する温度検出回路と、前記 変調回路の出力である変調電流値と、APC回路の出力 であるバイアス電流値をモニターし、変調電流とバイア ス電流の比が設定されたある値に一定となるように、前 記変調回路とAPC回路に制御信号を出力する演算回路 とを備えたことを特徴とする光送信器。

【請求項6】 入力された送信データ信号を変調制御し、変調電流を発光素子へ出力する変調回路と、前記発光素子の出力背面光を受光して光電変換する検出受光素子と、発光素子が発光するために必要な電流を供給する基準電流源と、前記検出受光素子にて変換された検出受光素子電流と基準電流源の基準電流との差に対応した発

光素子へのバイアス電流を供給するAPC(AutomaticPower Control)回路と、検出受光素子のバイアス電源と、前記変調回路の出力である変調電流値と、APC回路の出力であるバイアス電流値をモニターし、変調電流とバイアス電流の比が設定されたある値に一定となるように、前記変調回路とAPC回路に制御信号を出力する演算回路とを備えたことを特徴とする光送信器。

【請求項7】 入力された送信データ信号を変調制御 し、変調電流を発光素子へ出力する変調回路と、前記発 光素子の出力背面光を受光して光電変換する検出受光素 子と、前記発光素子が発光するために必要な電流を供給 する基準電流源と、前記検出受光素子にて変換された検 出受光素子電流と基準電流源の基準電流との差に対応し た発光素子へのバイアス電流を供給するAPC (Aut omatic Power Control)回路と、 検出受光素子のバイアス電源と、発光素子の温度を検出 する温度検出素子と、前記変調回路の出力である変調電 流値と、APC回路の出力であるバイアス電流値をモニ ターし、変調電流とバイアス電流の比が設定されたある 値に一定となるように、前記変調回路とAPC回路に制 御信号を出力する演算回路と、前記温度検出素子で検出 した温度を基に、前記変調回路から出力される変調電流 を調整するように制御信号を出力する発光素子温度検出 回路とを備えたことを特徴とする光送信器。

【請求項8】 入力された送信データ信号を変調制御 し、変調電流を発光素子へ出力する変調回路と、前記発 光素子の出力背面光を受光して光電変換する検出受光素 子と、前記発光素子が発光するために必要な電流を供給 する基準電流源と、前記検出受光素子にて変換された検 出受光素子電流と基準電流源の基準電流との差に対応し た発光素子へのバイアス電流を供給するAPC(Aut omatic Power Control)回路と、 検出受光素子のバイアス電源と、前記発光素子の周囲温 度を検出し、この検出した温度を基に、前記変調回路か ら出力される変調電流を調整するように制御信号を出力 する温度検出回路と、前記変調回路の出力である変調電 流値と、APC回路の出力であるバイアス電流値をモニ ターし、変調電流とバイアス電流の比が設定されたある 値に一定となるように、前記変調回路とAPC回路に制 御信号を出力する演算回路とを備えたことを特徴とする 光送信器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、特に光通信における光送信器に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の光送信器としては、例えば図10 に示す構成のものがある。図において、1は送信データ 信号を入力するデータ入力端子、2はデータ入力端子1 から入力された送信データ信号を変調制御し、変調電流を供給する変調回路、3は半導体レーザなどの発光素子、4は発光素子3の出力背面光を受光して光電変換する検出受光素子、5は発光素子3が発光するために必要な電流を供給する基準電流源、6は検出受光素子4にて変換された検出受光素子電流と基準電流源5の基準電流との差に比例した発光素子3へのバイアス電流を供給するAPC(Automatic Power Control)回路、7は検出受光素子4のバイアス電源、8は発光素子の温度を検出するサーミスタ、9は発光素子3の温度を制御するための冷却素子、10は冷却素子9の温度を制御する冷却素子制御回路である。

【0003】データ入力端子1に入力された送信データ 信号は変調回路2に入力される。この変調回路2は送信 データ信号に対応した電流を発生し発光素子3に変調電 流を出力する。基準電流源5は発光素子3の出力パワー が、必要とされるパワーとなるように基準電流をAPC 回路6へ供給する。検出受光素子4は発光素子3の出力 背面光を受光することにより光電変換により検出受光素 子電流が流れ、APC回路6へ出力する。APC回路6 には基準電流と検出受光素子電流の差電流が入力され、 一定倍率で増幅されて発光素子3へバイアス電流として 出力する。このAPC回路6への入力電流の変化によ り、発光素子3へのバイアス電流が制御される。つま り、発光素子3の光出力が大きくなると、検出受光素子 4から流れる検出受光素子電流が大きくなり、APC回 路6の出力電流が小さくなり、発光素子3の光出力は小 さくなる。逆に、発光素子3の光出力が小さくなると、 検出受光素子4から流れる検出受光素子電流が小さくな り、APC回路6の出力電流が大きくなり、発光素子3 の光出力は大きくなる。この負帰還動作により発光素子 3の光出力が一定となるように制御される。冷却素子9 とサーミスタ8はそれぞれ発光素子3の冷却、温度検出 のために発光素子3と接触するように設置される。冷却 素子制御回路10はサーミスタ8により検出された温度 を基に、発光素子3の温度を一定に保つように負帰還動 作により冷却素子9の冷却温度を制御する冷却素子制御 回路である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来の光送信器は上記のように構成されているため、外気温が-40~85℃の広範囲温度動作条件下では、特に85℃の高温度での動作のように、一般的な冷却素子の冷却限界温度ΔT=40℃を超えた条件で動作させた場合、外気温の上昇に併せて発光素子の温度も上昇してしまう。例えば、発光素子の温度を25℃に設定し、冷却素子の冷却限界温度ΔT=40℃の場合、外気温が65℃までは冷却素子により発光素子の温度が25℃に保たれるが、外気温が85℃においては、発光素子の温度が45℃に上昇する。レーザダイオードなどの発光素子は、図9に示すように

高温で順方向電流対光出力変換特性(以下、P-I特性と略す)のカーブが傾きを持つことが知られている。このため、発光素子を高温で動作させる場合は、発光素子の光出力パワーを一定に保つために、バイアス電流と、変調電流をともに増加させる必要がある。バイアス電流については、APC回路の負帰還動作により、光出力パワーを一定に保つように増加される。しかし、変調電流は、変調器への帰還機能がないため、最初に設定された変調電流値のままで動作するが、変調器自身が高温のため熱劣化を起こし、最初に設定された変調電流より低い電流しか流せないことが生じる。

【0005】この様に、光出カパワーは一定の状態で、 変調電流が少なくなると、発光素子の出力光の消光比が 悪くなり、最悪の場合、システムとして機能しなくなる ことがある。なお、低温側で使用する場合は、冷却素子 の冷却限界温度△T=40℃のものを用いても、発光素 子を暖める場合には、冷却限界温度を20~30℃程度 超えて暖めることが出来るため、-40℃で動作して も、発光素子の温度を25℃程度に設定されている場合 は、発光素子の温度が大きく変化することはないため、 問題にはならない。従来の構成のままで、85℃の高温 で動作させるためには、(1)発光素子の設定温度を4 5℃に設定し、85℃でも発光素子の温度を45℃に保 ち、一定の光出力、消光比を保つようにする、(2)発 光素子を広温度動作時もP-I特性の劣化の少ないもの を使用して高温動作時は、発光素子温度が上昇したまま で使用する、(3)冷却素子の冷却限界温度△T=60 ℃のものを使用する、或いは、(4)動作温度範囲を-15~65℃に限定して使用する、などがあげられる。 【0006】しかし、(1)発光素子の温度を45℃に 上げて使用した場合、発光素子の信頼性に影響が生じ る。また、-40℃などの低温では冷却素子が85℃ま での加熱能力はないため発光素子の温度も大きく下がっ てしまい、一定の変調電流駆動下では、消光比が増大す ることになる。消光比が増大することにより、光出力波 形が汚くなり、また、出力ジッタ特性も悪くなるため、 光送信器として温度特性の悪いものとなる。また、温度 特性の悪い光送信器からの出力を受信した場合、光受信 器に於いては、長距離伝送特性などが劣化するという問 題が生じることになり、光通信システム全体として不安 定になる、或いは、システムとして成り立たないことに なり、(2)P-I特性の劣化の少ない発光素子は高額 となり、P-I特性の劣化が少ないとはいえ、少なから ず劣化が生じるため、消光比の劣化や、変動が生じるこ とになり、この光出力を受信する光受信器に於いては、 受信感度劣化、変動が生じるため、光通信システムとし て不安定となり、(3)冷却限界温度の高い冷却素子を 使用する場合、冷却素子が高額になること、また、冷却 素子の消費電流が増加するため消費電力の増加に繋が り、(4)動作温度を制限してしまうと、システム要求 動作温度範囲を満たせなくなるため、システムとして成り立たなくなるという課題があった。

【 O O O 7 】この発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、発光素子の温度、または、発光素子の周囲温度の検出を行い、この検出した温度を基に、変調電流を調整するように変調器に帰還を追加する、或いは、バイアス電流と変調電流の比が一定となるように制御する帰還機能をAPC回路、及び、変調器に追加することにより、高温度動作時においても、光出力パワー、及び、消光比を一定に保つ温度補償機能を持った光送信器を構成することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】第1の発明の光送信器 は、送信データ信号を入力するデータ入力端子と、この データ入力端子から入力された送信データ信号を変調制 御し、変調電流を供給する変調回路と、半導体レーザな どの発光素子と、この発光素子の出力背面光を受光して 光電変換する検出受光素子と、発光素子が発光するため に必要な電流を供給する基準電流源と、検出受光素子に て変換された検出受光素子電流と基準電流源の基準電流 との差に比例した発光素子へのバイアス電流を供給する APC回路と、検出受光素子のバイアス電源と、発光素 子の温度を検出するサーミスタと、発光素子を冷却する 冷却素子と、冷却素子の温度を制御する冷却素子制御回 路と、この冷却素子制御回路でモニターした発光素子の 温度モニター値を基に、発光素子が設定された温度から 高い温度に上昇していないか検出し、温度が上昇してい た場合には変調回路から出力される変調電流を調整する ように制御信号を出力する温度変動検出回路により構成 されている。

【0009】また、第2の発明の光送信器は、送信デー 夕信号を入力するデータ入力端子と、このデータ入力端 子から入力された送信データ信号を変調制御し、変調電 流を供給する変調回路と、半導体レーザなどの発光素子 と、この発光素子の出力背面光を受光して光電変換する 検出受光素子と、発光素子が発光するために必要な電流 を供給する基準電流源と、検出受光素子にて変換された 検出受光素子電流と基準電流源の基準電流との差に比例 した発光素子へのバイアス電流を供給するAPC回路 と、検出受光素子のバイアス電源と、発光素子の温度を 検出するサーミスタと、発光素子を冷却する冷却素子 と、冷却素子の温度を制御する冷却素子制御回路と、発 光素子の周囲温度を検出し、この検出した温度を基に、 発光素子が設定された温度から高い温度に上昇していな いか検出し、温度が上昇していた場合には変調回路から 出力される変調電流を調整するように制御信号を出力す る温度検出回路により構成されている。

【0010】また、第3の発明の光送信器は、送信データ信号を入力するデータ入力端子と、このデータ入力端子と、から入力された送信データ信号を変調制御し、変調電

流を供給する変調回路と、半導体レーザなどの発光素子と、この発光素子の出力背面光を受光して光電変換する検出受光素子と、発光素子が発光するために必要な電流を供給する基準電流源と、検出受光素子にて変換された検出受光素子へのバイアス電流を供給するAPC回路と、検出受光素子のバイアス電源と、発光素子の温度を検出するサーミスタと、発光素子を冷却する冷却素子と、冷却素子の温度を制御する冷却素子制御回路と、変調回路の出力である変調電流値と、APC回路の出力であるバイアス電流値をモニターし、変調電流とバイアス電流の比が設定されたある値に一定となるように、変調回路とAPC回路に制御信号を出力する演算回路により構成されている。

【0011】また、第4の発明の光送信器は、送信デー 夕信号を入力するデータ入力端子と、このデータ入力端 子から入力された送信データ信号を変調制御し、変調電 流を供給する変調回路と、半導体レーザなどの発光素子 と、この発光素子の出力背面光を受光して光電変換する 検出受光素子と、発光素子が発光するために必要な電流 を供給する基準電流源と、検出受光素子にて変換された 検出受光素子電流と基準電流源の基準電流との差に比例 した発光素子へのバイアス電流を供給するAPC回路 と、検出受光素子のバイアス電源と、発光素子の温度を 検出するサーミスタと、発光素子を冷却する冷却素子 と、冷却素子の温度を制御する冷却素子制御回路と、こ の冷却素子制御回路でモニターした発光素子の温度モニ ター値を基に、発光素子が設定された温度から高い温度 に上昇していないか検出し、温度が上昇していた場合に は変調回路から出力される変調電流を調整するように制 御信号を出力する温度変動検出回路と、変調回路の出力 である変調電流値と、APC回路の出力であるバイアス 電流値をモニターし、変調電流とバイアス電流の比が設 定されたある値に一定となるように、変調回路とAPC 回路に制御信号を出力する演算回路により構成されてい

【0012】第5の発明の光送信器は、送信データ信号を入力するデータ入力端子と、このデータ入力端子から入力された送信データ信号を変調制御し、変調電流を供給する変調回路と、半導体レーザなどの発光素子と、この発光素子の出力背面光を受光して光電変換する検出受光素子と、発光素子が発光するために必要な電流を供給する基準電流源と、検出受光素子にて変換された検出受光素子電流と基準電流源の基準電流との差に比例した発光素子へのバイアス電源を供給するAPC回路と、検出受光素子のバイアス電源と、発光素子の温度を検出するサーミスタと、発光素子を冷却する冷却素子と、冷却素子の温度を制御する冷却素子制御回路と、発光素子の問囲温度を検出し、この検出した温度を基に、発光素子が設定された温度から高い温度に上昇していないか検出

し、温度が上昇していた場合には変調回路から出力される変調電流を調整するように制御信号を出力する温度検出回路と、変調回路の出力である変調電流値と、APC回路の出力であるバイアス電流値をモニターし、変調電流とバイアス電流の比が設定されたある値に一定となるように、変調回路とAPC回路に制御信号を出力する演算回路により構成されている。

【0013】また、第6の発明の光送信器は、送信データ信号を入力するデータ入力端子と、このデータ入力端子から入力された送信データ信号を変調制御し、変調電流を供給する変調回路と、半導体レーザなどの発光素子と、この発光素子の出力背面光を受光して光電変換する検出受光素子と、発光素子が発光するために必要な電流を供給する基準電流源と、検出受光素子にて変換された検出受光素子電流と基準電流源の基準電流との差に比例した発光素子へのバイアス電流を供給するAPC回路と、検出受光素子のバイアス電源と、変調回路の出力である変調電流値と、APC回路の出力であるバイアス電流の比が設定されたある値に一定となるように、変調回路とAPC回路に制御信号を出力する演算回路により構成されている。

【0014】第7の発明の光送信器は、送信データ信号 を入力するデータ入力端子と、このデータ入力端子から 入力された送信データ信号を変調制御し、変調電流を供 給する変調回路と、半導体レーザなどの発光素子と、こ の発光素子の出力背面光を受光して光電変換する検出受 光素子と、発光素子が発光するために必要な電流を供給 する基準電流源と、検出受光素子にて変換された検出受 光素子電流と基準電流源の基準電流との差に比例した発 光素子へのバイアス電流を供給するAPC回路と、検出 受光素子のバイアス電源と、発光素子の温度を検出する サーミスタと、変調回路の出力である変調電流値と、A PC回路の出力であるバイアス電流値をモニターし、変 調電流とバイアス電流の比が設定されたある値に一定と なるように、変調回路とAPC回路に制御信号を出力す る演算回路と、サーミスタにより発光素子の温度を検出 し、この検出した温度を基に、変調回路から出力される 変調電流を調整するように制御信号を出力する発光素子 温度検出回路により構成されている。

【 O O 1 5 】また、第8の発明の光送信器は、送信データ信号を入力するデータ入力端子と、このデータ入力端子から入力された送信データ信号を変調制御し、変調電流を供給する変調回路と、半導体レーザなどの発光素子と、この発光素子の出力背面光を受光して光電変換する検出受光素子と、発光素子が発光するために必要な電流を供給する基準電流源と、検出受光素子にて変換された検出受光素子電流と基準電流源の基準電流との差に比例した発光素子へのバイアス電流を供給するAPC回路と、検出受光素子のバイアス電源と、発光素子の周囲温

度を検出し、この検出した温度を基に、変調回路から出力される変調電流を調整するように制御信号を出力する温度検出回路と、変調回路の出力である変調電流値と、APC回路の出力であるバイアス電流値をモニターし、変調電流とバイアス電流の比が設定されたある値に一定となるように、変調回路とAPC回路に制御信号を出力する演算回路により構成されている。

[0016]

【発明の実施の形態】実施の形態1.図1はこの発明の実施の形態1による光送信器を示す構成図である。図において1から10は従来の光送信器の構成と同一であり、11は冷却素子制御回路10でモニターした発光素子3の温度モニター値を基に、変調回路2から出力される変調電流を調整するように制御信号を出力する温度変動検出回路である。

【0017】次に動作について説明する。データ入力端 子1に入力された送信データ信号は変調回路2に入力さ れる。この変調回路2は送信データ信号に対応した電流 を発生し発光素子3に変調電流を印加する。基準電流源 5は発光素子3の出力パワーが、必要とされるパワーと なるように基準電流をAPC回路6へ出力する。検出受 光素子4は発光素子3の出力背面光を受光することによ り光電変換により検出受光素子電流が流れ、APC回路 6へ出力される。APC回路6には基準電流と検出受光 素子電流の差電流が入力され、一定倍率で増幅されて発 光素子3へバイアス電流として出力される。このAPC 回路6への入力電流の変化により、発光素子3へのバイ アス電流が制御される。 つまり、発光素子3の光出力が 大きくなると、検出受光素子4から流れる検出受光素子 電流が大きくなり、APC回路6の出力電流が小さくな り、発光素子3の光出力は小さくなる。逆に、発光素子 3の光出力が小さくなると、検出受光素子4から流れる 検出受光素子電流が小さくなり、APC回路6の出力電 流が大きくなり、発光素子3の光出力は大きくなる。こ の負帰還動作により発光素子3の光出力が一定となるよ うに制御される。サーミスタ8と冷却素子9はそれぞれ 発光素子3の温度検出、冷却(温度制御)のために発光 素子3と接触するように設置される。冷却素子制御回路 10はサーミスタ8により検出された温度を基に、発光 素子3の温度を一定に保つように負帰還動作により冷却 素子9の冷却温度を制御する。温度変動検出回路11は 冷却素子制御回路10でモニターした発光素子3の温度 モニター値を基に、発光素子3が設定された温度から高 い温度に上昇していないか検出し、温度が上昇していた 場合には変調回路2から出力される変調電流を調整し、 発光素子3の出力光の消光比を一定に保つように制御信 号を出力する。

【0018】上記のように、冷却素子制御回路10でモニターした発光素子3の温度モニター値を基に、温度変動検出回路11により発光素子3の温度変動を検出し、

消光比を一定に保つように制御信号を変調回路2へ出力する帰還機能を追加することにより、高温動作時に発光素子3の温度が設定値よりも上昇した場合においても、この変調回路2への帰還機能とAPC回路6の動作により、発光素子3の光出力パワーと消光比を常に一定に保つことができる。

【0019】実施の形態2.図2はこの発明の実施の形態2による光送信器を示す構成図である。図において1から10は従来の光送信器の構成と同一であり、12は発光素子3の周囲温度をモニターするために、発光素子3の近辺に設置され、この温度モニター値を基に、変調回路2から出力される変調電流を調整するように制御信号を出力する温度検出回路である。

【0020】次に動作について説明する。データ入力端 子1に入力された送信データ信号は変調回路2に入力さ れる。この変調回路2は送信データ信号に対応した電流 を発生し発光素子3に変調電流を印加する。基準電流源 5は発光素子3の出力パワーが、必要とされるパワーと なるように基準電流をAPC回路6へ出力する。検出受 光素子4は発光素子3の出力背面光を受光することによ り光電変換により検出受光素子電流が流れ、APC回路 6へ出力される。APC回路6には基準電流と検出受光 素子電流の差電流が入力され、一定倍率で増幅されて発 光素子3へバイアス電流として出力される。このAPC 回路6への入力電流の変化により、発光素子3へのバイ アス電流が制御される。つまり、発光素子3の光出力が 大きくなると、検出受光素子4から流れる検出受光素子 電流が大きくなり、APC回路6の出力電流が小さくな り、発光素子3の光出力は小さくなる。逆に、発光素子 3の光出力が小さくなると、検出受光素子4から流れる 検出受光素子電流が小さくなり、APC回路6の出力電 流が大きくなり、発光素子3の光出力は大きくなる。こ の負帰還動作により発光素子3の光出力が一定となるよ うに制御される。サーミスタ8と冷却素子9はそれぞれ 発光素子3の温度検出、冷却のために発光素子3と接触 するように設置される。冷却素子制御回路10はサーミ スタ8により検出された温度を基に、発光素子3の温度 を一定に保つように負帰還動作により冷却素子9の冷却 温度を制御する。温度検出回路12は発光素子3の周囲 温度をモニターし、このモニターした周囲温度を基に、 変調回路2から出力される変調電流を調整し、発光素子 3の出力光の消光比を一定に保つように制御信号を出力

【0021】上記のように、温度検出回路12でモニターした発光素子3の周囲温度モニター値を基に、消光比を一定に保つように制御信号を変調回路2へ出力する帰還機能を追加することにより、高温動作時に発光素子3の温度が上昇した場合においても、この変調回路2への帰還機能とAPC回路6の動作により、発光素子3の光出力パワーと消光比を常に一定に保つことができる。

【0022】実施の形態3.図3はこの発明の実施の形態3による光送信器を示す構成図である。図において1から10は従来の光送信器の構成と同一であり、13は変調回路2の出力である変調電流とAPC回路6の出力であるバイアス電流をモニターし、バイアス電流と変調電流の比が一定となるように演算し、制御信号を変調回路2とAPC回路6に出力する演算回路である。

【0023】次に動作について説明する。データ入力端 子1に入力された送信データ信号は変調回路2に入力さ れる。この変調回路2は送信データ信号に対応した電流 を発生し発光素子3に変調電流を印加する。基準電流源 5は発光素子3の出力パワーが、必要とされるパワーと なるように基準電流をAPC回路6へ出力する。検出受 光素子4は発光素子3の出力背面光を受光することによ り光電変換により検出受光素子電流が流れ、APC回路 6へ出力される。APC回路6には基準電流と検出受光 素子電流の差電流が入力され、一定倍率で増幅されて発 光素子3へバイアス電流として出力される。このAPC 回路6への入力電流の変化により、発光素子3へのバイ アス電流が制御される。つまり、発光素子3の光出力が 大きくなると、検出受光素子4から流れる検出受光素子 電流が大きくなり、APC回路6の出力電流が小さくな り、発光素子3の光出力は小さくなる。逆に、発光素子 3の光出力が小さくなると、検出受光素子4から流れる 検出受光素子電流が小さくなり、APC回路6の出力電 流が大きくなり、発光素子3の光出力は大きくなる。こ の負帰還動作により発光素子3の光出力が一定となるよ うに制御される。サーミスタ8と冷却素子9はそれぞれ 発光素子3の温度検出、冷却のために発光素子3と接触 するように設置される。冷却素子制御回路10はサーミ スタ8により検出された温度を基に、発光素子3の温度 を一定に保つように負帰還動作により冷却素子9の冷却 温度を制御する。演算回路13は変調回路2の出力であ る変調電流と、APC回路6の出力であるバイアス電流 をモニターし、この変調電流とバイアス電流が高温にお ける発光素子3のP-I特性から、最適な消光比と光出 カパワーとなるような変調電流とバイアス電流の比を決 めておき、変調電流とバイアス電流がこの決められた比 の値となるように変調回路2とAPC回路6の制御信号 を出力し、発光素子3の出力光の消光比を一定に保つよ うに制御信号を出力する。

【0024】上記のように、演算回路13でモニターした変調電流とバイアス電流を基に、常に最適な消光比、光出力パワーとなるような変調電流とバイアス電流の比を決めておき、変調電流とバイアス電流がこの決められた比の値を保つように制御信号を変調回路2とAPC回路6に出力する機能を追加することにより、高温動作時に発光素子3の温度が設定値よりも上昇した場合においても、変調電流とバイアス電流が常に一定の比となるように変調回路2とAPC回路6へ帰還が掛かるようにな

り、発光素子3の光出力パワーと消光比を常に一定に保 つことができる。

【0025】実施の形態4.図4はこの発明の実施の形態4による光送信器を示す構成図である。図において1から10は従来の光送信器の構成と同一であり、11は冷却素子制御回路10でモニターした発光素子3の温度モニター値を基に、変調回路2から出力される変調電流を調整するように制御信号を出力する温度変動検出回路であり、13は変調回路2の出力である変調電流とAPC回路6の出力であるバイアス電流をモニターし、バイアス電流と変調電流の比が一定となるように演算し、制御信号を変調回路2とAPC回路6に出力する演算回路である。

【0026】次に動作について説明する。データ入力端 **子1に入力された送信データ信号は変調回路2に入力さ** れる。この変調回路2は送信データ信号に対応した電流 を発生し発光素子3に変調電流を印加する。基準電流源 5は発光素子3の出力パワーが、必要とされるパワーと なるように基準電流をAPC回路6へ出力する。検出受 光素子4は発光素子3の出力背面光を受光することによ り光電変換により検出受光素子電流が流れ、APC回路 6へ出力される。APC回路6には基準電流と検出受光 素子電流の差電流が入力され、一定倍率で増幅されて発 光素子3へバイアス電流として出力される。このAPC 回路6への入力電流の変化により、発光素子3へのバイ アス電流が制御される。つまり、発光素子3の光出力が 大きくなると、検出受光素子4から流れる検出受光素子 電流が大きくなり、APC回路6の出力電流が小さくな り、発光素子3の光出力は小さくなる。

【0027】逆に、発光素子3の光出力が小さくなる と、検出受光素子4から流れる検出受光素子電流が小さ くなり、APC回路6の出力電流が大きくなり、発光素 子3の光出力は大きくなる。この負帰還動作により発光 素子3の光出力が一定となるように制御される。サーミ スタ8と冷却素子9はそれぞれ発光素子3の温度検出、 冷却のために発光素子3と接触するように設置される。 冷却素子制御回路10はサーミスタ8により検出された 温度を基に、発光素子3の温度を一定に保つように負帰 還動作により冷却素子9の冷却温度を制御する。温度変 動検出回路11は冷却素子制御回路10でモニターした 発光素子3の温度モニター値を基に、発光素子3が設定 された温度から高い温度に上昇していないか検出し、温 度が上昇していた場合には変調回路2から出力される変 調電流を調整し、発光素子3の出力光の消光比を一定に 保つように制御信号を出力する。

【0028】演算回路13は変調回路2の出力である変調電流と、APC回路6の出力であるバイアス電流をモニターし、この変調電流とバイアス電流が高温における発光素子3のP-I特性から、最適な消光比と光出力パワーとなるような変調電流とバイアス電流の比を決めて

おき、変調電流とバイアス電流がこの決められた比の値となるように変調回路2とAPC回路6の制御信号を出力し、発光素子3の出力光の消光比を一定に保つように制御信号を出力する。

【0029】上記のように、冷却素子制御回路10でモ ニターした発光素子3の温度モニター値を基に、温度変 動検出回路11により発光素子3の温度変動を検出し、 消光比を一定に保つように制御信号を変調回路2へ出力 する帰還機能と、演算回路13でモニターした変調電流 とバイアス電流を基に、常に最適な消光比、光出力パワ ーとなるような変調電流とバイアス電流の比を決めてお き、変調電流とバイアス電流がこの決められた比の値を 保つように制御信号を変調回路2とAPC回路6に出力 する機能を組み合わせて使用することにより、高温動作 時に発光素子3の温度が設定値よりも上昇した場合にお いても、発光素子3の温度変動とともに変調電流が調整 され、かつ、調整された変調電流を基に、変調電流とバ イアス電流が常に一定の比となるように変調回路2とA PC回路6へ帰還が掛かるようになるため、発光素子3 の温度変化に併せて変調電流とバイアス電流が制御でき るようになり、発光素子3の光出力パワーと消光比を常 に一定に保つことができる。

【0030】実施の形態5.図5はこの発明の実施の形態5による光送信器を示す構成図である。図において1から10は従来の光送信器の構成と同一であり、12は発光素子3の周囲温度をモニターするために、発光素子3の近辺に設置され、この温度モニター値を基に、変調回路2から出力される変調電流を調整するように制御信号を出力する温度検出回路であり、13は変調回路2の出力である変調電流とAPC回路6の出力であるバイアス電流をモニターし、バイアス電流と変調電流の比が一定となるように演算し、制御信号を変調回路2とAPC回路6に出力する演算回路である。

【0031】次に動作について説明する。データ入力端 子1に入力された送信データ信号は変調回路2に入力さ れる。この変調回路2は送信データ信号に対応した電流 を発生し発光素子3に変調電流を印加する。基準電流源 5は発光素子3の出力パワーが、必要とされるパワーと なるように基準電流をAPC回路6へ出力する。検出受 光素子4は発光素子3の出力背面光を受光することによ り光電変換により検出受光素子電流が流れ、APC回路 6へ出力される。APC回路6には基準電流と検出受光 素子電流の差電流が入力され、一定倍率で増幅されて発 光素子3へバイアス電流として出力される。このAPC 回路6への入力電流の変化により、発光素子3へのバイ アス電流が制御される。つまり、発光素子3の光出力が 大きくなると、検出受光素子4から流れる検出受光素子 電流が大きくなり、APC回路6の出力電流が小さくな り、発光素子3の光出力は小さくなる。

【0032】逆に、発光素子3の光出力が小さくなる

と、検出受光素子4から流れる検出受光素子電流が小さ くなり、APC回路6の出力電流が大きくなり、発光素 子3の光出力は大きくなる。この負帰還動作により発光 素子3の光出力が一定となるように制御される。サーミ スタ8と冷却素子9はそれぞれ発光素子3の温度検出、 冷却のために発光素子3と接触するように設置される。 冷却素子制御回路10はサーミスタ8により検出された 温度を基に、発光素子3の温度を一定に保つように負帰 還動作により冷却素子9の冷却温度を制御する。温度検 出回路12は発光素子3の周囲温度をモニターし、この モニターした周囲温度を基に、変調回路2から出力され る変調電流を調整し、発光素子3の出力光の消光比を一 定に保つように制御信号を出力する。 演算回路 13 は変 調回路2の出力である変調電流と、APC回路6の出力 であるバイアス電流をモニターし、この変調電流とバイ アス電流が高温における発光素子3のP-I特性から、 最適な消光比と光出力パワーとなるような変調電流とバ イアス電流の比を決めておき、変調電流とバイアス電流 がこの決められた比の値となるように変調回路2とAP C回路6の制御信号を出力し、発光素子3の出力光の消 光比を一定に保つように制御信号を出力する。

【0033】上記のように、温度検出回路12でモニタ ーした発光素子3の周囲温度モニター値を基に、消光比 を一定に保つように制御信号を変調回路2へ出力する帰 **還機能と、演算回路13でモニターした変調電流とバイ** アス電流を基に、常に最適な消光比、光出力パワーとな るような変調電流とバイアス電流の比を決めておき、変 調電流とバイアス電流がこの決められた比の値を保つよ うに制御信号を変調回路2とAPC回路6に出力する機 能を組み合わせて使用することにより、高温動作時に発 光素子3の温度が上昇した場合においても、発光素子3 の温度変動とともに変調電流が調整され、かつ、調整さ れた変調電流を基に、変調電流とバイアス電流が常に一 定の比となるように変調回路2とAPC回路6へ帰還が 掛かるようになるため、発光素子3の温度変化に併せて 変調電流とバイアス電流が制御できるようになり、発光 素子3の光出カパワーと消光比を常に一定に保つことが

【0034】実施の形態6.図6はこの発明の実施の形態6による光送信器を示す構成図である。図において1 から7は従来の光送信器の構成と同一であり、13は変調回路2の出力である変調電流とAPC回路6の出力であるバイアス電流をモニターし、バイアス電流と変調電流の比が一定となるように演算し、制御信号を変調回路2とAPC回路6に出力する演算回路である。

【0035】次に動作について説明する。データ入力端子1に入力された送信データ信号は変調回路2に入力される。この変調回路2は送信データ信号に対応した電流を発生し発光素子3に変調電流を印加する。基準電流源5は発光素子3の出力パワーが、必要とされるパワーと

なるように基準電流をAPC回路6へ出力する。検出受光素子4は発光素子3の出力背面光を受光することにより光電変換により検出受光素子電流が流れ、APC回路6へ出力される。APC回路6には基準電流と検出受光素子電流の差電流が入力され、一定倍率で増幅されて発光素子3へバイアス電流として出力される。このAPC回路6への入力電流の変化により、発光素子3へのバイアス電流が制御される。つまり、発光素子3の光出力が大きくなると、検出受光素子4から流れる検出受光素子電流が大きくなり、APC回路6の出力電流が小さくなり、発光素子3の光出力は小さくなる。

【0036】逆に、発光素子3の光出力が小さくなると、検出受光素子4から流れる検出受光素子電流が小さくなり、APC回路6の出力電流が大きくなり、発光素子3の光出力は大きくなる。この負帰還動作により発光素子3の光出力が一定となるように制御される。演算回路13は変調回路2の出力である変調電流と、APC回路6の出力であるバイアス電流をモニターし、この変調電流とバイアス電流が高温における発光素子3のP-I特性から、最適な消光比と光出力パワーとなるような変調電流とバイアス電流の比を決めておき、変調電流とバイアス電流の比を決めておき、変調電流とバイアス電流がこの決められた比の値となるように変調回路2とAPC回路6の制御信号を出力し、発光素子3の出力光の消光比を一定に保つように制御信号を出力する。

【0037】上記のように、演算回路13でモニターした変調電流とバイアス電流を基に、常に最適な消光比、光出力パワーとなるような変調電流とバイアス電流の比を決めておき、変調電流とバイアス電流がこの決められた比の値を保つように制御信号を変調回路2とAPC回路6に出力する機能を追加することにより、高温動作時に発光素子3の温度が上昇した場合においても、変調電流とバイアス電流が常に一定の比となるように変調回路2とAPC回路6へ帰還が掛かるようになり、発光素子3の光出力パワーと消光比を常に一定に保つことができる。

【0038】実施の形態7.図7はこの発明の実施の形態7による光送信器を示す構成図である。図において1から8は従来の光送信器の構成と同一であり、13は変調回路2の出力である変調電流とAPC回路6の出力であるバイアス電流をモニターし、バイアス電流と変調回路2とAPC回路6に出力する演算回路である。14は発光素子3温度検出のために発光素子3と接触するように設置されたサーミスタ8により検出された温度モニター値を基に、変調回路2から出力される変調電流を調整するように制御信号を出力する発光素子温度検出回路である。

【0039】次に動作について説明する。データ入力端 子1に入力された送信データ信号は変調回路2に入力さ れる。この変調回路2は送信データ信号に対応した電流を発生し発光素子3に変調電流を印加する。基準電流源5は発光素子3の出力パワーが、必要とされるパワーとなるように基準電流をAPC回路6へ出力する。検出受光素子4は発光素子3の出力背面光を受光することにより光電変換により検出受光素子電流が流れ、APC回路6へ出力される。APC回路6には基準電流と検出受光素子電流の差電流が入力され、一定倍率で増幅されて発光素子3へバイアス電流として出力される。このAPC回路6への入力電流の変化により、発光素子3へのバイアス電流が制御される。つまり、発光素子3の光出力が大きくなると、検出受光素子4から流れる検出受光素子電流が大きくなり、APC回路6の出力電流が小さくなり、発光素子3の光出力は小さくなる。

【0040】逆に、発光素子3の光出力が小さくなる と、検出受光素子4から流れる検出受光素子電流が小さ くなり、APC回路6の出力電流が大きくなり、発光素 子3の光出力は大きくなる。この負帰還動作により発光 素子3の光出力が一定となるように制御される。サーミ スタ8と冷却素子9はそれぞれ発光素子3の温度検出、 冷却のために発光素子3と接触するように設置される。 冷却素子制御回路10はサーミスタ8により検出された 温度を基に、発光素子3の温度を一定に保つように負帰 還動作により冷却素子9の冷却温度を制御する。 演算回 路13は変調回路2の出力である変調電流と、APC回 路6の出力であるバイアス電流をモニターし、この変調 電流とバイアス電流が高温における発光素子3のP-I 特性から、最適な消光比と光出力パワーとなるような変 調電流とバイアス電流の比を決めておき、変調電流とバ イアス電流がこの決められた比の値となるように変調回 路2とAPC回路6の制御信号を出力し、発光素子3の 出力光の消光比を一定に保つように制御信号を出力す る。発光素子温度検出回路14はサーミスタ8により検 出された発光素子3の温度モニター値を基に、発光素子 3の温度を検出し、温度が上昇している場合には変調回 路2から出力される変調電流を調整し、発光素子3の出 力光の消光比を一定に保つように制御信号を出力する。 【0041】上記のように、演算回路13でモニターし た変調電流とバイアス電流を基に、常に最適な消光比、 光出力パワーとなるような変調電流とバイアス電流の比 を決めておき、変調電流とバイアス電流がこの決められ た比の値を保つように制御信号を変調回路2とAPC回 路6に出力する機能と、発光素子温度検出回路14でモ ニターした発光素子3の温度モニター値を基に、発光素 子3の温度を検出し、消光比を一定に保つように制御信 号を変調回路2へ出力する帰還機能を組み合わせて使用 することにより、高温動作時に発光素子3の温度が上昇 した場合においても、発光素子3の温度変動とともに変 調電流が調整され、かつ、調整された変調電流を基に、 変調電流とバイアス電流が常に一定の比となるように変 調回路 2 と A P C 回路 6 へ帰還が掛かるようになるため、発光素子3 の温度変化に併せて変調電流とバイアス電流が制御できるようになり、発光素子3 の光出力パワーと消光比を常に一定に保つことができる。

【0042】実施の形態8.図8はこの発明の実施の形態8による光送信器を示す構成図である。図において1から7は従来の光送信器の構成と同一であり、12は発光素子3の周囲温度をモニターするために、発光素子3の近辺に設置され、この温度モニター値を基に、変調回路2から出力される変調電流を調整するように制御信号を出力する温度検出回路であり、13は変調回路2の出力である変調電流とAPC回路6の出力であるバイアス電流をモニターし、バイアス電流と変調電流の比が一定となるように演算し、制御信号を変調回路2とAPC回路6に出力する演算回路である。

【0043】次に動作について説明する。データ入力端 子1に入力された送信データ信号は変調回路2に入力さ れる。この変調回路2は送信データ信号に対応した電流 を発生し発光素子3に変調電流を印加する。基準電流源 5は発光素子3の出力パワーが、必要とされるパワーと なるように基準電流をAPC回路6へ出力する。検出受 光素子4は発光素子3の出力背面光を受光することによ り光電変換により検出受光素子電流が流れ、APC回路 6へ出力される。APC回路6には基準電流と検出受光 素子電流の差電流が入力され、一定倍率で増幅されて発 光素子3へバイアス電流として出力される。このAPC 回路6への入力電流の変化により、発光素子3へのバイ アス電流が制御される。 つまり、発光素子3の光出力が 大きくなると、検出受光素子4から流れる検出受光素子 電流が大きくなり、APC回路6の出力電流が小さくな り、発光素子3の光出力は小さくなる。

【0044】逆に、発光素子3の光出力が小さくなる と、検出受光素子4から流れる検出受光素子電流が小さ くなり、APC回路6の出力電流が大きくなり、発光素 子3の光出力は大きくなる。この負帰還動作により発光 素子3の光出力が一定となるように制御される。温度検 出回路12は発光素子3の周囲温度をモニターし、この モニターした周囲温度を基に、変調回路2から出力され る変調電流を調整し、発光素子3の出力光の消光比を一 定に保つように制御信号を出力する。 演算回路13は変 調回路2の出力である変調電流と、APC回路6の出力 であるバイアス電流をモニターし、この変調電流とバイ アス電流が高温における発光素子3のP-I特性から、 最適な消光比と光出力パワーとなるような変調電流とバ イアス電流の比を決めておき、変調電流とバイアス電流 がこの決められた比の値となるように変調回路2とAP C回路6の制御信号を出力し、発光素子3の出力光の消 光比を一定に保つように制御信号を出力する。

【0045】上記のように、温度検出回路12でモニターした発光素子3の周囲温度モニター値を基に、消光比

を一定に保つように制御信号を変調回路2へ出力する帰還機能と、演算回路13でモニターした変調電流とバイアス電流を基に、常に最適な消光比、光出力パワーとなるような変調電流とバイアス電流の比を決めておき、変調電流とバイアス電流がこの決められた比の値を保つように制御信号を変調回路2とAPC回路6に出力する機能を組み合わせて使用することにより、高温動作時に発光素子3の温度が上昇した場合においても、発光素子3の温度変動とともに変調電流が調整され、かつ、調整された変調電流を基に、変調電流とバイアス電流が常に一定の比となるように変調回路2とAPC回路6へ帰還が掛かるようになるため、発光素子3の温度変化に併せて変調電流とバイアス電流が制御できるようになり、発光素子3の光出力パワーと消光比を常に一定に保つことができる。

[0046]

【発明の効果】第1の発明によれば、発光素子の温度モニター値を基に、温度変動検出回路により発光素子の温度変動を検出し、消光比を一定に保つように制御信号を変調回路へ出力する帰還機能を追加することにより、高温動作時に発光素子の温度が設定値よりも上昇した場合においても、この変調回路への帰還機能とAPC回路の動作により、発光素子の光出力パワーと消光比を常に一定に保つことができる。

【0047】第2の発明によれば、発光素子の周囲温度 モニター値を基に、消光比を一定に保つように制御信号 を変調回路へ出力する帰還機能を追加することにより、 高温動作時に発光素子の温度が上昇した場合において も、この変調回路への帰還機能とAPC回路の動作によ り、発光素子の光出力パワーと消光比を常に一定に保つ ことができる。

【0048】第3の発明によれば、演算回路でモニターした変調電流とバイアス電流を基に、常に最適な消光比、光出力パワーとなるような変調電流とバイアス電流がこの決められた比の値を保つように制御信号を変調回路とAPC回路に出力する機能を追加することにより、高温動作時に発光素子の温度が設定値よりも上昇した場合においても、変調電流とバイアス電流が一定の比となるように変調回路2とAPC回路へ帰還が掛かるようになり、発光素子の光出力パワーと消光比を常に一定に保つことができる。

【0049】第4の発明によれば、発光素子の温度モニター値を基に、温度変動検出回路により発光素子の温度変動を検出し、消光比を一定に保つように制御信号を変調回路へ出力する帰還機能と、演算回路でモニターした変調電流とバイアス電流を基に、常に最適な消光比、光出力パワーとなるような変調電流とバイアス電流の比を決めておき、変調電流とバイアス電流がこの決められた比の値を保つように制御信号を変調回路とAPC回路に

出力する機能を組み合わせて使用することにより、高温動作時に発光素子の温度が設定値よりも上昇した場合においても、発光素子の温度変動とともに変調電流が調整され、かつ、調整された変調電流を基に、変調電流とバイアス電流が常に一定の比となるように変調回路とAP C回路へ帰還が掛かるようになるため、発光素子の温度変化に併せて変調電流とバイアス電流が制御できるようになり、発光素子の光出力パワーと消光比を一定に保つことができる。

【0050】第5の発明によれば、発光素子の周囲温度 モニター値を基に、消光比を一定に保つように制御信号 を変調回路へ出力する帰還機能と、演算回路でモニター した変調電流とバイアス電流を基に、常に最適な消光 比、光出力パワーとなるような変調電流とバイアス電流 の比を決めておき、変調電流とバイアス電流がこの決め られた比の値を保つように制御信号を変調回路とAPC 回路に出力する機能を組み合わせて使用することによ り、高温動作時に発光素子の温度が上昇した場合におい ても、発光素子の温度変動とともに変調電流が調整さ れ、かつ、調整された変調電流を基に、変調電流とバイ アス電流が常に一定の比となるように変調回路とAPC 回路へ帰還が掛かるようになるため、発光素子の温度変 化に併せて変調電流とバイアス電流が制御できるように なり、発光素子の光出力パワーと消光比を一定に保つこ とができる。

【0051】第6の発明によれば、演算回路でモニターした変調電流とバイアス電流を基に、常に最適な消光比、光出力パワーとなるような変調電流とバイアス電流の比を決めておき、変調電流とバイアス電流がこの決められた比の値を保つように制御信号を変調回路とAPC回路に出力する機能を追加することにより、高温動作時に発光素子の温度が上昇した場合においても、変調電流とバイアス電流が一定の比となるように変調回路とAPC回路へ帰還が掛かるようになり、発光素子の光出力パワーと消光比を一定に保つことができる。

【0052】第7の発明によれば、演算回路でモニターした変調電流とバイアス電流を基に、常に最適な消光比、光出力パワーとなるような変調電流とバイアス電流がこの決められた比の値を保つように制御信号を変調回路とAPC回路に出力する機能と、発光素子の温度モニター値を基に、発光素子の温度を検出し、消光比を一定に保つように制御信号を変調回路へ出力する帰還機能を組み合わせて使用することにより、高温動作時に発光素子の温度が上昇した場合においても、発光素子の温度変動とともに変調電流が調整され、かつ、調整された変調電流を基に、変調電流とバイアス電流が常に一定の比となるよう

に変調回路とAPC回路へ帰還が掛かるようになるため、発光素子の温度変化に併せて変調電流とバイアス電流が制御できるようになり、発光素子の光出力パワーと消光比を一定に保つことができる。

【0053】第8の発明によれば、発光素子の周囲温度 モニター値を基に、消光比を一定に保つように制御信号 を変調回路へ出力する帰還機能と、演算回路でモニター した変調電流とバイアス電流を基に、適切な消光比、光 出力パワーとなるような変調電流とバイアス電流の決められた 比の値を保つように制御信号を変調回路とAPC回路に 出力する機能を組み合わせて使用することにより、高温 動作時に発光素子の温度が上昇した場合においても、発 光素子の温度変動とともに変調電流が調整され、かつ、 調整された変調電流を基に、変調電流とバイアス電流が 一定の比となるように変調電流とバイアス電流が かるようになるため、発光素子の温度変化に併せて変調 電流とバイアス電流が制御できるようになり、発光素子 の光出力パワーと消光比を一定に保つことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明による光送信器の実施の形態1を示す図である。

【図2】 この発明による光送信器の実施の形態2を示す図である。

【図3】 この発明による光送信器の実施の形態3を示す図である。

【図4】 この発明による光送信器の実施の形態4を示す図である。

【図5】 この発明による光送信器の実施の形態5を示す図である。

【図6】 この発明による光送信器の実施の形態6を示す図である。

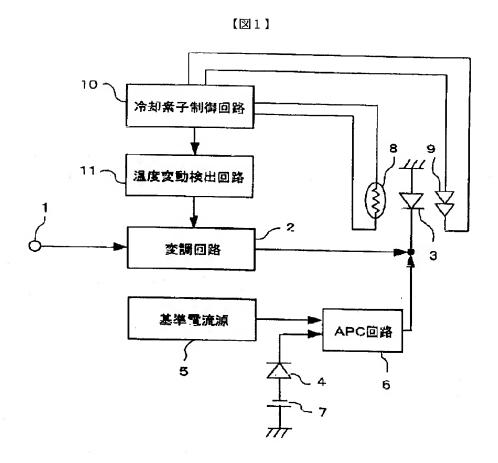
【図7】 この発明による光送信器の実施の形態7を示す図である。

【図8】 この発明による光送信器の実施の形態8を示す図である。

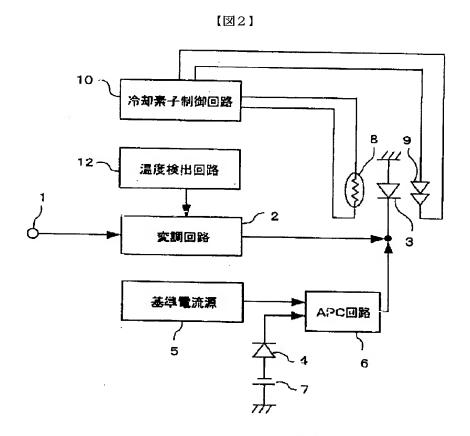
【図9】 従来の送信器における発光素子の順方向電流 対光出力変換特性を示す図である。

【図10】 従来の光送信器を示す図である。 【符号の説明】

1 データ入力端子、2 変調回路、3 発光素子、4 検出受光素子、5基準電流源、6 APC回路、7 バイアス電源、8 サーミスタ、9 冷却素子、10 冷却素子制御回路、11 温度変動検出回路、12 温 度検出回路、13 演算回路、14 発光素子温度検出 回路。

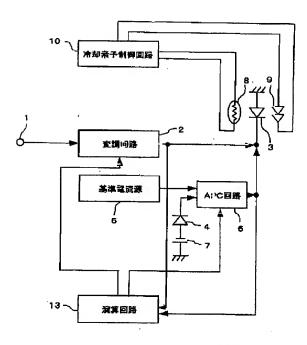


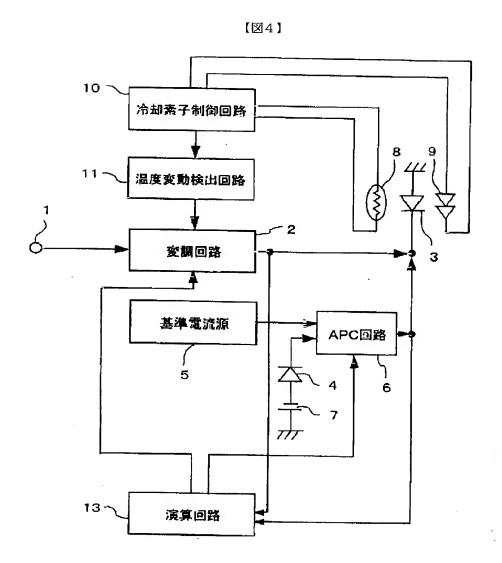
11:温度変動検出回路

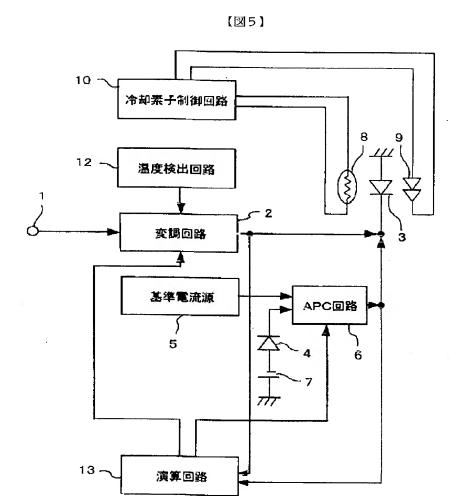


12:温度変動検出回路

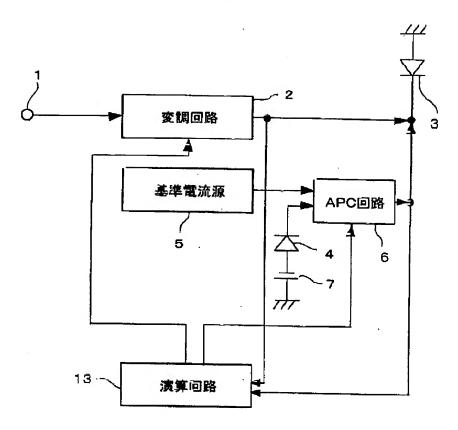
【図3】



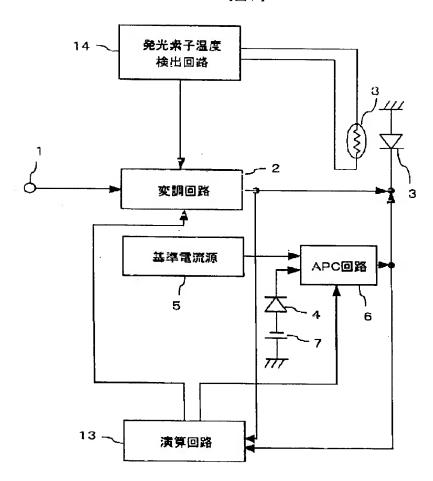




【図6】

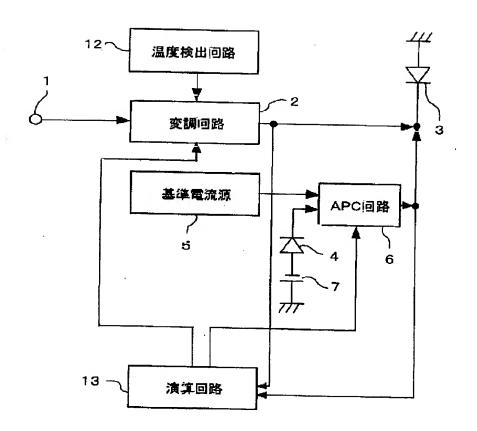


【図7】

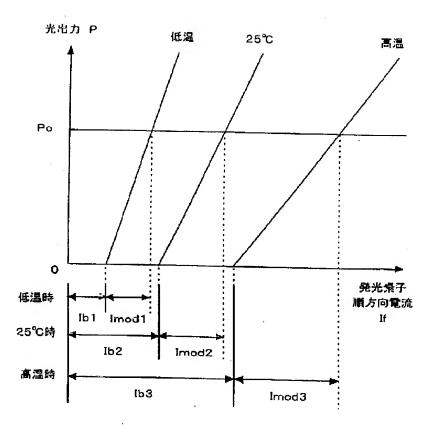


14:発光素子温度検出回路

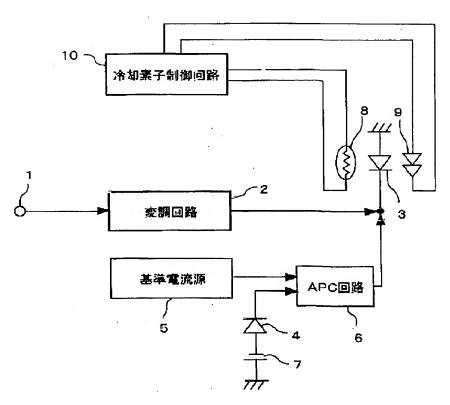
【図8】







【図10】



- 1:データ入力端子
- 2:変調回路
- 3:発光素子
- 4:検出受光素子
- 5:基準電流源
- 6:APC回路
- 7:バイアス電源
- 8:サーミスタ
- 9:冷却漂子
- 10:冷却素子制御回路